

High Efficiency Thyristor

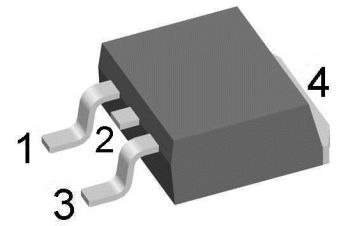
V_{RRM}	=	800 V
I_{TAV}	=	20 A
V_T	=	1.31 V

Single Thyristor

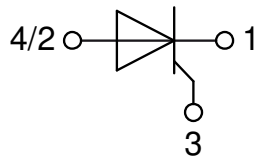
Part number

CS19-08ho1S

Marking on Product: CS19-08ho1S



Backside: anode



Features / Advantages:

- Thyristor for line frequency
- Planar passivated chip
- Long-term stability

Applications:

- Line rectifying 50/60 Hz
- Softstart AC motor control
- DC Motor control
- Power converter
- AC power control
- Lighting and temperature control

Package: TO-263 (D2Pak)

- Industry standard outline
- RoHS compliant
- Epoxy meets UL 94V-0

Disclaimer Notice

Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, users should independently evaluate the suitability of and test each product selected for their own applications. Littelfuse products are not designed for, and may not be used in, all applications. Read complete Disclaimer Notice at www.littelfuse.com/disclaimer-electronics.

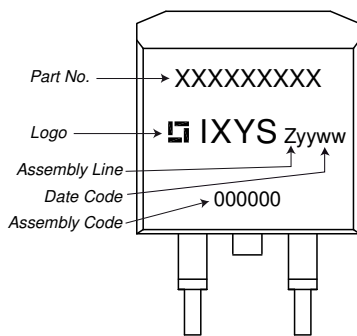


Thyristor			Ratings			
Symbol	Definition	Conditions	min.	typ.	max.	Unit
$V_{RSM/DSM}$	max. non-repetitive reverse/forward blocking voltage	$T_{VJ} = 25^{\circ}C$			900	V
$V_{RRM/DRM}$	max. repetitive reverse/forward blocking voltage	$T_{VJ} = 25^{\circ}C$			800	V
I_{RD}	reverse current, drain current	$V_{R/D} = 800 V$	$T_{VJ} = 25^{\circ}C$		50	μA
		$V_{R/D} = 800 V$	$T_{VJ} = 125^{\circ}C$		1	mA
V_T	forward voltage drop	$I_T = 20 A$	$T_{VJ} = 25^{\circ}C$		1.32	V
		$I_T = 40 A$			1.65	V
		$I_T = 20 A$	$T_{VJ} = 125^{\circ}C$		1.31	V
		$I_T = 40 A$			1.73	V
I_{TAV}	average forward current	$T_C = 110^{\circ}C$	$T_{VJ} = 125^{\circ}C$		20	A
$I_{T(RMS)}$	RMS forward current	180° sine			31	A
V_{T0}	threshold voltage	} for power loss calculation only	$T_{VJ} = 125^{\circ}C$		0.86	V
r_T	slope resistance				22	m Ω
R_{thJC}	thermal resistance junction to case				0.7	K/W
R_{thCH}	thermal resistance case to heatsink			0.50		K/W
P_{tot}	total power dissipation		$T_C = 25^{\circ}C$		170	W
I_{TSM}	max. forward surge current	$t = 10 \text{ ms}; (50 \text{ Hz}), \text{ sine}$	$T_{VJ} = 45^{\circ}C$		180	A
		$t = 8,3 \text{ ms}; (60 \text{ Hz}), \text{ sine}$	$V_R = 0 V$		195	A
		$t = 10 \text{ ms}; (50 \text{ Hz}), \text{ sine}$	$T_{VJ} = 125^{\circ}C$		155	A
		$t = 8,3 \text{ ms}; (60 \text{ Hz}), \text{ sine}$	$V_R = 0 V$		165	A
I^2t	value for fusing	$t = 10 \text{ ms}; (50 \text{ Hz}), \text{ sine}$	$T_{VJ} = 45^{\circ}C$		160	A ² s
		$t = 8,3 \text{ ms}; (60 \text{ Hz}), \text{ sine}$	$V_R = 0 V$		160	A ² s
		$t = 10 \text{ ms}; (50 \text{ Hz}), \text{ sine}$	$T_{VJ} = 125^{\circ}C$		120	A ² s
		$t = 8,3 \text{ ms}; (60 \text{ Hz}), \text{ sine}$	$V_R = 0 V$		115	A ² s
C_J	junction capacitance	$V_R = 230 V \quad f = 1 \text{ MHz}$	$T_{VJ} = 25^{\circ}C$		9	pF
P_{GM}	max. gate power dissipation	$t_p = 30 \mu s$	$T_C = 125^{\circ}C$		5	W
		$t_p = 300 \mu s$			2.5	W
P_{GAV}	average gate power dissipation				0.5	W
$(di/dt)_{cr}$	critical rate of rise of current	$T_{VJ} = 150^{\circ}C; f = 50 \text{ Hz}$	repetitive, $I_T = 60 A$		150	A/ μs
		$t_p = 200 \mu s; di_G/dt = 0.15 A/\mu s;$ $I_G = 0.15 A; V = \frac{2}{3} V_{DRM}$	non-repet., $I_T = 20 A$		500	A/ μs
$(dv/dt)_{cr}$	critical rate of rise of voltage	$V = \frac{2}{3} V_{DRM}$	$T_{VJ} = 150^{\circ}C$		500	V/ μs
		$R_{GK} = \infty$; method 1 (linear voltage rise)				
V_{GT}	gate trigger voltage	$V_D = 6 V$	$T_{VJ} = 25^{\circ}C$		1.5	V
			$T_{VJ} = -40^{\circ}C$		2.5	V
I_{GT}	gate trigger current	$V_D = 6 V$	$T_{VJ} = 25^{\circ}C$		28	mA
			$T_{VJ} = -40^{\circ}C$		50	mA
V_{GD}	gate non-trigger voltage	$V_D = \frac{2}{3} V_{DRM}$	$T_{VJ} = 150^{\circ}C$		0.2	V
I_{GD}	gate non-trigger current				3	mA
I_L	latching current	$t_p = 10 \mu s$	$T_{VJ} = 25^{\circ}C$		75	mA
		$I_G = 0.1 A; di_G/dt = 0.1 A/\mu s$				
I_H	holding current	$V_D = 6 V \quad R_{GK} = \infty$	$T_{VJ} = 25^{\circ}C$		50	mA
t_{gd}	gate controlled delay time	$V_D = \frac{1}{2} V_{DRM}$	$T_{VJ} = 25^{\circ}C$		2	μs
		$I_G = 0.1 A; di_G/dt = 0.1 A/\mu s$				
t_q	turn-off time	$V_R = 100 V; I_T = 20 A; V = \frac{2}{3} V_{DRM}$ $di/dt = 10 A/\mu s \quad dv/dt = 20 V/\mu s \quad t_p = 200 \mu s$	$T_{VJ} = 100^{\circ}C$		150	μs



Package TO-263 (D2Pak)			Ratings			
Symbol	Definition	Conditions	min.	typ.	max.	Unit
I_{RMS}	RMS current	per terminal			35	A
T_{VJ}	virtual junction temperature		-40		125	°C
T_{op}	operation temperature		-40		100	°C
T_{stg}	storage temperature		-40		150	°C
Weight				2		g
F_C	mounting force with clip		20		60	N

Product Marking



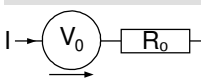
Ordering	Ordering Number	Marking on Product	Delivery Mode	Quantity	Code No.
Standard	CS19-08ho1S-TRL	CS19-08ho1S	Tape & Reel	800	489204
Alternative	CS19-08ho1S-TUB	CS19-08ho1S	Tube	50	473332

Similar Part	Package	Voltage class
CS19-08ho1	TO-220AB (3)	800
CS19-12ho1	TO-220AB (3)	1200
CS19-12ho1S	TO-263AB (D2Pak) (2)	1200

Equivalent Circuits for Simulation

* on die level

$T_{VJ} = 125\text{ °C}$



Thyristor

$V_{0\ max}$	threshold voltage	0.86	V
$R_{0\ max}$	slope resistance *	19	mΩ

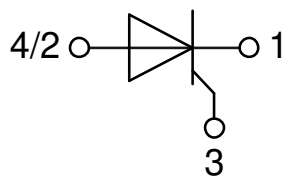


Outlines TO-263 (D2Pak)



Dim.	Millimeter		Inches	
	min	max	min	max
A	4.06	4.83	0.160	0.190
A1	typ. 0.10		typ. 0.004	
A2	2.41		0.095	
b	0.51	0.99	0.020	0.039
b2	1.14	1.40	0.045	0.055
c	0.40	0.74	0.016	0.029
c2	1.14	1.40	0.045	0.055
D	8.38	9.40	0.330	0.370
D1	8.00	8.89	0.315	0.350
D2	2.5		0.098	
E	9.65	10.41	0.380	0.410
E1	6.22	8.50	0.245	0.335
e	2,54 BSC		0,100 BSC	
e1	4.28		0.169	
H	14.61	15.88	0.575	0.625
L	1.78	2.79	0.070	0.110
L1	1.02	1.68	0.040	0.066
W	typ. 0.02	0.040	typ. 0.0008	0.002

All dimensions conform with and/or within JEDEC standard.



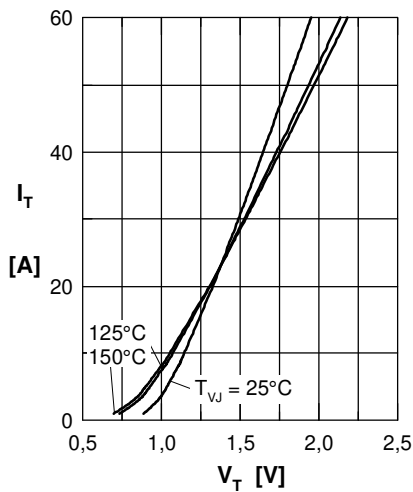
Thyristor


Fig. 1 Forward characteristics

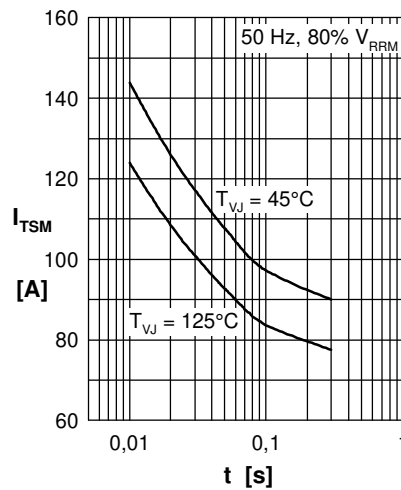


Fig. 2 Surge overload current

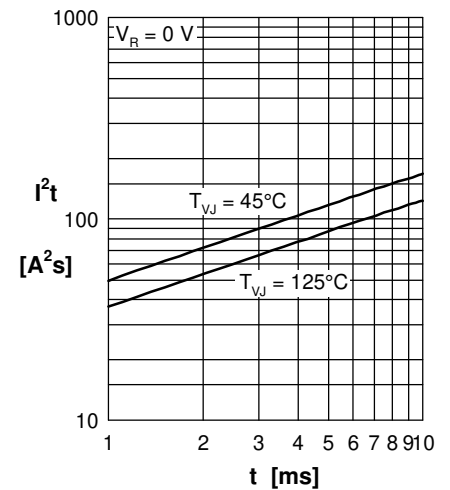
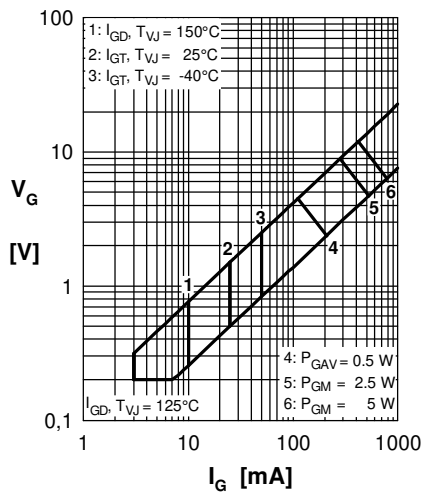

 Fig. 3 I^2t versus time (1-10 ms)


Fig. 4 Gate trigger characteristics



Fig. 5 Gate controlled delay time

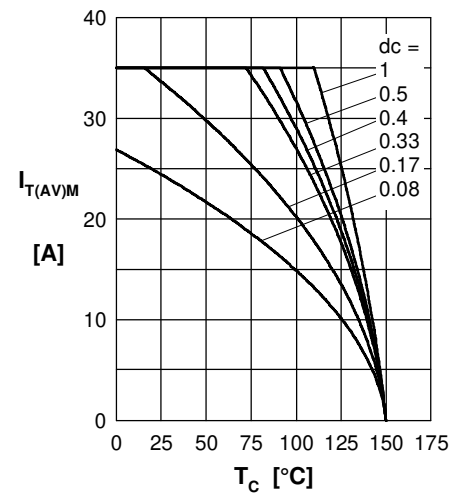


Fig. 6 Max. forward current at case temperature

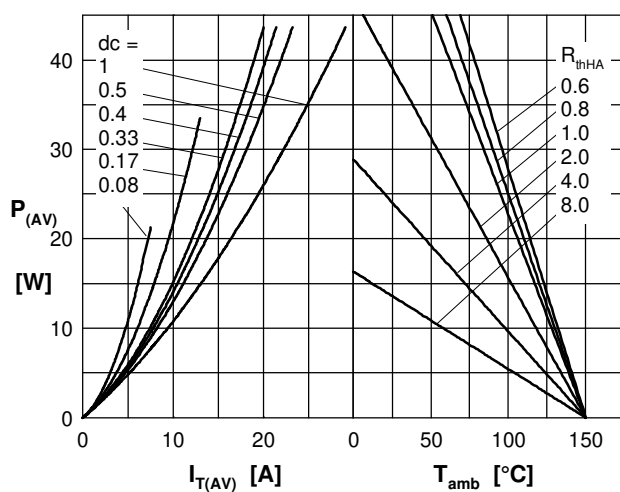
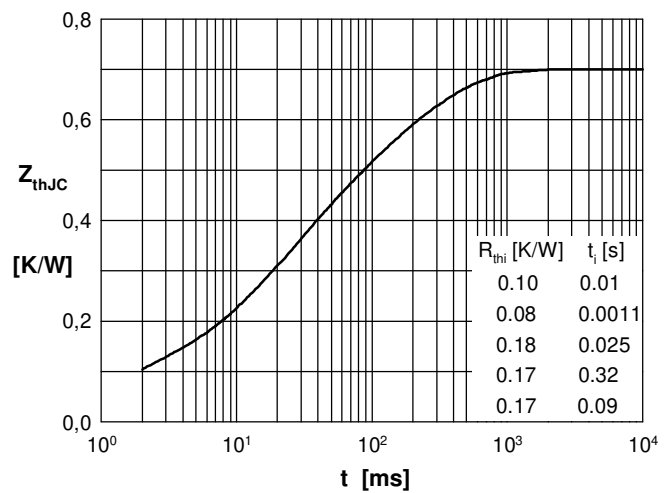

 Fig. 7a Power dissipation versus direct output current
 Fig. 7b and ambient temperature


Fig. 8 Transient thermal impedance junction to case



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331